法政大学学術機関リポジトリ

HOSEI UNIVERSITY REPOSITORY

PDF issue: 2025-07-04

マイクロセン断応力計と離散ウエーブレット 解析による壁面せん断応力の可視化と探知

KIMURA, Motoaki / 木村, 元昭 / 武居, 昌宏 / 宮城, 徳誠 / HO, Chih-Ming / 齊藤, 兆古 / 堀井, 清之 / TAKEI, Masahiro / MIYAGI, Norimasa / HO, Chih-Ming / SAITO, Yoshifuru / HORII, Kiyoshi

(出版者 / Publisher)
The Institute of Electrical Engineers of Japan / 社団法人電気学会
(雑誌名 / Journal or Publication Title)
電気学会論文誌 E, センサ・マイクロマシン準部門誌 / 電気学会論文誌 E, セン サ・マイクロマシン準部門誌
(号 / Number)
6
(開始ページ / Start Page)
272
(終了ページ / End Page)
279
(発行年 / Year)
2000-06-01

論 文

マイクロせん断応力計と離散ウェーブレット解析による 壁面せん断応力の可視化と探知

非会員	木	村	元	昭	(日本大学)	非会員	武	居	昌	宏	(日本大学)
非会員	宮	城	徳	誠	(日本大学)	非会員	非会員 Chih-Mir		ing	HO	(UCLA)
正員	斎	藤	兆	古	(法政大工)	非会員	堀	井	清	之	(白百合女子大)

Visualization and Detection of Wall Shear Stress using Micro Shear Stress Sensor and Discrete Wavelet Analysis

Motoaki Kimura, Masahiro Takei, Norimasa Miyagi (Nihon Univ.), Chih-Ming HO (UCLA), Yoshifuru SAITO (Hosei Univ.) Kiyoshi HORII (Shirayuri College)

Shear stress stripe structure on the wall in turbulent boundary layer has been clearly visualized by a combination of a shear stress sensor using MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) and discrete wavelets transform. The MEMS shear stress micro chip is designed and fabricated by surface micro-machining technology, contributing to obtaining the time-space two dimensional shear stress data. One array of 25 micro shear stress sensors in the chip that covers a length of 7.5 mm is used to measure the instantaneous spanwise distribution of the surface shear stress. The discrete wavelets transform is a software technique to decompose the frequency level with the time and space information of the wave form. In details, the structure in lower Reynolds number is shown clearly on lower frequency wavelets level, the structure in high Reynolds number is done clearly on higher frequency wavelets level. To visualize and detect the high shear stress area more clearly, the frequency levels are recomposed using the multiresolution filtering effect of wavelets transform. The experiments for the shear stress distribution were carried out on Re = 8700 and 17400.

キーワード: MEMS, 乱流境界層, せん断応力計, 離散ウェーブレット変換, 可視化

1. はじめに

乱流境界層内の編構造は壁面近傍の支配的な流れ構造で あることから可視化、実験および数値計算による研究が精 力的に進められている ¹⁾⁻⁵⁾。ところが、レイノルズ数が高く なるに従いその編構造は小さくなるために、その可視化に は高い空間分解能と周波数応答が必要となり、従来のセン サでは測定が困難であった。このような現状に対して、米 国の UCLA とカリフォルニア工科大学では乱流境界層のせん 断応力制御を念頭において、マイクロマシン技術 (MEMS Micro Electro Mechanical Systems)によるセンサ, アクチ ュエータおよび電子回路を一体化した制御システムの設計 製作を行っており、壁面せん断応力編構造の時間空間准2 次元分布の高精度な可視化に成功している。しかしながら, このような MEMS せん断応カイメージチップから可視化され るせん断応力分布は、様々な周波数成分を合成した積分値 であり、さらなる詳細な編構造の解析においては、統計的 手法や周波数解析といった新しい解析手法が必要であるこ とは言うまでもない。筆者らは、その統計的手法として、 せん断応力編構造波形のスロープと最大値との相関関係を 明らかにし、詳細な編構造の解析を行った⁷⁾。一方、周波数 解析についてはフーリエ変換を行うことが常套手段ではあ

るが、このような解析手法を時間空間的に准2次元平面で 得られる MEMS せん断応力分布に適用すると,時間空間成分 が消去され周波数成分だけの情報となってしまうために、 その准2次元渦構造の時間空間情報が得られにくいと言う 大きな欠点が存在した。このような状況において最近にな って時間空間情報を残したまま周波数特性を得る手段とし てウェーブレット解析が注目を集めており⁸⁾, 流体工学分野 における乱流構造の解析、電磁気分野における波形の解析 など、あらゆる波形の解析に用いられてきた。筆者の一人 斎藤らは,正規直交系である離散ウェーブレットを電磁界 計算へ応用 ⁹⁰し、ノイズフィルタ評価に適用した ¹⁰⁰。さら に、筆者らは、離散ウェーブレットの特徴のひとつである 正規直交系の多重解像度解析を噴流の解析に適用した 11. このような離散ウェーブレット解析が、波動解析に多用さ れてきているものの、その准2次元せん断応力画像に対し ては、その適用がまったくなされていない。

本研究は、マイクロせん断応力計により、乱流境界層に おける壁面せん断応力分布を空間・時間の準2次元的に測 定し、その2次元データに離散値系ウェーブレット変換を 用いて壁面せん断応力分布を可視化¹²⁾すると共にその特徴 抽出を行い、高せん応力の推定に有効な情報を得ることを 目的としている。

2. センサと実験装置

〈2・1〉 マイクロせん断応力イメージチップ 測定に 用いたマイクロせん断応カイメージチップの拡大図を図1 に示す。チップ上には図2に示すようなセンサ配列が形成 されている。1列に25個のせん断応力センサが並ぶ列が3 列(①、④、⑤),1列に5個のセンサが並ぶ列が2列(②、 ③)の計 85 個のセンサ群から構成されている。各センサは 後述の回路に接続されており、単独あるいは同時に複数の センサを作動させることが可能である。複数のセンサを用 いる場合は、流れと直角な1列25個のセンサ列を用いるこ とで壁面せん断応力分布の時系列変化を計測することがで きる。また、3行25列あるいは4行5列の行列状のセンサ 群を用いることで、せん断応力の平面分布の時系列変化を 測定することができる。更にせん断応カイメージチップを 構成する個々のマイクロせん断応力センサ¹³⁾は、図3に示 したように、上部を窒化シリコン薄膜でコーティングした 多結晶ポリシリコン製である。1つのセンサを形成する大 きさは、200µm×200µmの正方形であり、隣り合うセンサ の中心間隔は 300 µm, 各センサ本体は長さ 150 µm, 幅 3 µm, 厚さ0.45μmの線状で、厚さ1.2μmの窒化シリコン板上に 位置している。断熱のために下部に厚さ2µmの真空空洞が あり、センサから壁面への熱伝導が減少しセンサ感度が顕 著に向上する14)。センサは定温度型熱線流速計と同様の回 路を用い加熱比 1.1 で作動する。センサの較正は後に示す ように時間平均出力を圧力勾配より得られる時間平均せん 断応力と比較することにより行った。センサ出力感度は 1V/Pa, 周波数応答は矩形波によれば 25kHz である。

〈2・2〉 マイクロせん断応カイメージチップ製造工程 本マイクロせん断応力イメージチップは現在、カリフォル ニアエ科大学内にある U-MACHINES 社が製造販売を行ってい る。上述した1つのセンサの製造工程を図4に示し概説す る¹⁵⁾。図4(1)では、Si 基板上に減圧化学的気相成長法 (LPCVD) で形成した窒化シリコン層を湿式シリコンエッチ ングにより窓状パターン(真空断熱のための空洞部 200× 200 µm) で掘り下げる。同図(2)では、熱酸化成長法(LOCOS) を施して表面を平滑化する。同図(3)では、真空空洞のため の溶解部としてリン・ケイ酸ガラス(PSG)をパターン化しな がら形成する。同図(4)では、ダイアフラム材として窒化シ リコンを一面に被着する。同図(5)では、窒化シリコン層に 穴を開け、弗化水素酸によりPSG層とその下面の熱酸化 物を除去する。同図(6)では、ウエハを乾燥した後、真空状 態で空洞を封印するために減圧下で窒化シリコン層を形成 する 16)。 同図(7)では、ホットフィルムを形成するために 多結晶シリコン層をパターン形成し、イオン注入法でリン を添加する。形成された多結晶シリコン内のストレスを低 減し、添加した不純物を活性化するためにアニールしてセ ンサ部とする。更に、多結晶ポリシリコン抵抗体の抵抗値 のドリフトを防ぐ目的で、抵抗体を不活性化するための窒



図1 マイクロせん断応カイメージチップ Fig. 1. A micro shear stress imaging chip.







図3 せん断応力センサ(a)断面図, (b)平面図 Fig. 3. A shear stress sensor.



図4 製造工程¹⁵⁾ Fig. 4. Fabrication steps.¹⁵⁾



図 5 定温度型回路 Fig.5. Constant temperature circuit.

化シリコン膜を減圧化学的気相成長法(LPCVD)により形成 する¹⁷⁷。同図(8)では、アルミニウム配線によりリードを 作成する。

〈2.3〉センサの較正と温度補償 センサは上述のよう に定温度型回路で作動する。図5に本実験で使用した回路 を示す。同回路はセンサ:Rs、固定抵抗器:Rl、R2 および 可変抵抗器 Roによるホイーストン・ブリッジと広帯域帰還 増幅器により構成される。この増幅器の出力をブリッジに 戻すことにより、センサの温度を与えられた設定温度の値 に、壁面せん断応力に関係なく一定に保つようにする。し たがってセンサの抵抗値も一定となる。壁面せん断応力に 変動が生じた場合、センサを初期設定温度に保つように回 路に電流が流れ、この電流を測定することにより、壁面せ ん断応力および変動分を検出することができる。

センサに通電したときのジュール熱が強制対流により壁 面近傍の流体に伝達する熱流束を測定することにより二次 的に壁面せん断応力を求めるもので,熱流束と壁面せん断 応力での関係は,

 $i^{2}R^{2} = (T_{f} - T)(A + B\tau^{1/3})$... (1)

である⁽¹⁸⁾。ここに, T_iは熱せられたセンサ温度, Tは被測 定流の温度であり, Rはセンサの抵抗値, iはセンサを流 れる加熱電流であり, AとBは実験定数である。また, 今 回用いたセンサの温度特性は

Rs=2.5181(1+0.001307 Δ T) [kΩ] ・・・・・(2) である⁶。ここでΔTは温度変化を示す。

ここでは壁面せん断応力と出力電圧値の関係を明らかに するために次の2つの方法を用いた。始めに、チャネル風 洞の乱流に発達した領域の壁面せん断応力。は、

 $\tau = a_0 + a_1 E_0 + \dots + a_6 E_0^6$ ・・・・・・・・・・・・・・(4) で示すことができる。ここに、 a_0 、 a_1 , ・・・、 a_6 は較正定 数である。この定数はチャネル風洞により較正される。す なわち、乱れが充分に発達した位置での風洞壁面に、セン サ受感部を壁面と同一平面になるように設置し、風洞の主 流速度とセンサの出力電圧との関係を調べる。次にもう片 方の較正方法を示す。完全に発達したチャネル乱流でのレ イノルズ数と壁面せん断応力の関係は、Hussain ら⁽¹³⁾の実 験によれば、

式(4)において、測定流体の温度は一定と仮定している が、実際の風洞内の温度は実験中に変化するため、温度補 償が必要となる。中心速度10m/sのチャネル流、室温19℃ から22℃の範囲で、壁面せん断応力センサと壁面近傍に設 置された熱電対により温度補償の補正率を求めた。本研究 で使用したセンサの温度に対する出力の変化は、-310mV/℃ であった。温度補償は、まずせん断応力値と周囲温度を測 定した後にプログラム上で行った。

〈2.4〉実験装置・条件・方法 本実験に用いたチャネ ル型風洞を図6(a)に示す。高さ25.4mm,幅610mmの矩形断 面,長さ4880mmのチャネル型風洞を用い行われた。その風 洞内において,はじめに熱線流速計を用いて流速分布測定 を行い,チャネル入り口付近で層流,後半では乱流になる ことを確認した。マイクロせん断応カイメージチップの設 置状況は図6(b)に示すように特製 PC ボードに収められ, 更にチャネル入り口より4267mm下流の完全に乱流に遷移し ている位置に壁面と凸凹がない様に設置された。そして, チャネル高さ(h=25.4×10⁻³m)の半分の高さと,その中央速



図6 センサ装着状況と風洞 Fig.6. Sensor setting and wind tunnel.

度によるレイノルズ Re が 8700(v=10m/s) および 17400(v=20m/s)の2種類の実験条件で実施された。今回は 流れと直角方向の壁面せん断応力分布の時系列データに関 してウェーブレット変換を施すために、前述した第1列 (①)の25個のセンサ列により長さ7.5mmの範囲で流れ方 向の壁面せん断応力の時間変化を測定した。

3. 離散ウェーブレット変換

離散ウェーブレット変換の行列表現は、

S=WX ·····(7) で表させ、Sはウェーブレットスペクトラム、Wはアナライ ジングウェーブレット行列、Xは入力データである。Wは次 の行列 C を基本として、カスケードアルゴリズムにより求 めることができる。その行列 C は、 4 次の Daubechies 関 数 (N=4)の場合、

	(c.	с,	<i>c</i> 2	с,	0	0	٠	0	0	0	0	}	1+√3			
	c,	- c ₂	c 1	- c 0	0	0	•	0	0	0	0	C.	4√2			
	0	0	c _o	c,	<i>c</i> ₂	с,	٠	0	0	0	0		3+√3			
	0	0	c,	- c ₁	c,	- c ₀	•	0	0	0	0	[^c , '	4√2			
С-		·	•	•	·	٠	٠	•	•	•	•		3- \sqrt{3}			
	0	0	0	0	0	0	•	c,	c,	ϵ_{2}	с,	C2	4√2			
	0	0	0	0	0	0	•	с,	- c ₂	<i>c</i> 1	- c _o		$\frac{1-\sqrt{3}}{3}$			
	c2	с,	0	0	0	0	·	0	0	<i>c</i> ₀	<i>c</i> 1	5	4√2			
	(c,	۰ c ₀	0	0	0	0	•	0	0	c,	- c2)				
													• •	•	· (8)
с,	-	c_{z}	+ c	, -	c _o	= 0			•	•	• •	•	••	• •	• (9))
0	$0 \ c_3 - 1 \ c_2 + 2 \ c_1 - 3 \ c_0 = 0 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (10)$															

であり、ここで、**C^T・C = I**, *I* は単位行列、**C^T** は **C** の転置行 列である。式(8)の行列 **C** の1行目はスケーリン

グ係数であり、2 行目はウェーブレット係数である。4 次の Daubechies 関数 (N=4) は、各行に4 個の係数をもち、第1 行目は、 c₀, c₁, c₂ と c₃ を重みに持つ入力データの和の 演算である。第2 行目は c₀, c₁, c₂ と c₃ を重みに持つ入力 データの差の演算である。3 行目は1 行目を2 ステップ移動 したもの、4 行目は2 行目を2 ステップ移動したものである。 式(9) と (10) より、入力行列の各要素が一定または単調増 加である場合には、変換された値は0 になる。行列 **C**から **■** を求めるカスケードアルゴリズムについて、説明を容易に するために、入力行列 X は、

 $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & x_8 & x_9 & x_{10} & x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} & x_{15} & x_{16} \end{bmatrix}^T$ $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (11)$

のように1次元16要素からなるものとする。式(8)と(11) より、変換行列 X は、

 $\mathbf{X}' = \mathbf{C}_{16}\mathbf{X} = [s_1 \ d_1 \ s_2 \ d_2 \ s_3 \ d_3 \ s_4 \ d_4 \ s_5 \ d_5 \ s_6 \ d_6 \ s_7 \ d_7 \ s_8 \ d_8 \]^T$

となり、**C₁₈ は 16X16 の C**行列である。この式(12)で要素 s は和の演算を行ったものを示し、要素 d は差の演算を行っ たものを示す。

次に、この **X**の中の要素の位置を行列 **P**₁₈ によって変換する。

 $\boldsymbol{P}_{16}\boldsymbol{X}' = [s_1 \ s_2 \ s_3 \ s_4 \ s_5 \ s_6 \ s_7 \ s_8 \ d_1 \ d_2 \ d_3 \ d_4 \ d_5 \ d_6 \ d_7 \ d_8]^T \\ \cdot \cdot \cdot \cdot (13)$

そしてさらに、式(13)に対して、C と P 行列によって変換 を続ける。すなわち、

 $\mathbf{W}^{(2)}\mathbf{X} = [S_1 \ S_2 \ S_3 \ S_4 \ D_1 \ D_2 \ D_3 \ D_4 \ d_1 \ d_2 \ d_3 \ d_4 \ d_5 \ d_6 \ d_7 \ d_8]^{T}$ $\cdot \cdot \cdot \cdot (14)$

の演算を施す。ここで、

 $\begin{aligned} \mathbf{W}^{(2)} &= (\mathbf{P}_{16}^{*}'\mathbf{C}_{16}^{*}) (\mathbf{P}_{16}^{*}\mathbf{C}_{16}^{*}) & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & (16) \\ \mathbf{W}^{(3)} &= (\mathbf{P}_{16}^{*}', \mathbf{C}_{16}^{*}') (\mathbf{P}_{16}^{*}, \mathbf{C}_{16}^{*}) (\mathbf{P}_{16}^{*}\mathbf{C}_{16}^{*}) & \cdots & \cdots & (17) \\ \mathbf{P}_{16}^{*} - \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{8} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{8} \end{bmatrix} \mathbf{C}_{16}^{*} - \begin{bmatrix} \mathbf{C}_{8} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{8} \end{bmatrix} \mathbf{P}_{16}^{**} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{4} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{12} \end{bmatrix} \mathbf{C}_{16}^{**} - \begin{bmatrix} \mathbf{C}_{4} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{12} \end{bmatrix} \\ & \cdots & \cdots & (18) \end{aligned}$

I⁽³⁾ は式(7)のアナライジングウェーブレット行列**<math>I**である。 式(14)において、 S_i は式(15)における s_1 から s_4 までの重 みを付けた和を示す。 S_2 は s_3 から s_6 までの重みを付けた 和を示し、 D_i は式(15)における s_1 から s_4 までの重みを付け た差を示す。式(15)で、 S_1 は式(14)における S_1 から S_4 ま での重みを付けた和を示し、 D_i は式(14)の S_1 から S_4 まで の重みを付けた差を示す。式(15)から、離散ウェーブレッ ト逆変換は、

 $X = [W^{(3)}]^{\mathsf{T}}S_0 + [W^{(3)}]^{\mathsf{T}}S_1 + [W^{(3)}]^{\mathsf{T}}S_2 + [W^{(3)}]^{\mathsf{T}}S_3$

...(21)

である。以上から、入力行列の要素数が 16 で 4 次の Daubechies 関数を用いた場合、多重解像度は、Level 0 か ら Level 3 まで存在する。2 次元離散ウェーブレットスペク

電学論E, 120巻6号, 平成12年

トラムSは、縦方向のウェーブレット変換について、Xの左 からn行のm列の W,を掛け算して求め、横方向のウェーブ レット変換について、X の右から W/を掛け算することで求 められ、そのSは、

 $S = W_{n} \cdot X \cdot W_{n}^{T}$ · · · · · · · · · · · · · · (23) で表せられる。ここで、₩」は₩。の転置行列を示す。このウ ェーブレット逆変換は(23)式の左右から掛け算した変換行 列を単位正方行列とすればよいので、

. (24) X= W, T.S.W. で表される。

一般的に、入力行列の要素が 2″ 個で k 次 (N=k)の Daubechies 関数を用いた場合、その多重解像度解析は、式 (20)において、 変換された和の要素の数が k より小さく なるまで、繰り返し和と差の演算が続けられる。本研究に おいては、アナライジングウェーブレットとしてドビッシ ー(Daubechies)16 次関数を用いた。その基本行列 C の1行 目のスケーリング係数、および2行目のウェーブレット係 数は16個の係数からなるウェーブレット変換は上記のアル ゴリズムによりウェーブレット係数からなる基本波に対し て、そのスケール変換および時間空間シフトを行い、多数 のスケールおよび時間空間が異なる波形から構成されるア ナライジングウェーブレットを用いて、入力波形を変換す るものである。この 16 次の Daubechies 関数も, 4 次の Daubechies 関数と基本的な性質は同様であり、C'・C=I すな わち、正規直交の関係が存在する。

4. ウェーブレット解析結果と考察

〈4.1〉 壁面せん断応力の可視化 図7はマイクロせん 断応カイメージチップにより測定された、時空間准2次元 せん断応力分布を、最大値を 1.0 に最小値を 0.0 に正規化 して濃淡で示したものであり、せん断応力の高いところは 淡色(A)で、低いところは濃色(B)で示されている。この 図において、センサから得られる流れと直角方向(横方向) のデータ数は 25(幅 7.5mm)であり、離散ウェーブレット変 換は2のべき乗を対象とするので、26から32までの値には 意図的に0を入れた。また、時間軸(縦方向)は、51.2msを 変換対象としたが、図には10msの範囲を示してある。レイ ノルズ数が高くなるに従い、相対的に高いせん断応力が集 中する編状の領域は、流れと直角方向の幅が狭く、流れ方 向に短くなることが分かる。図7に対して離散ウェーブレ ット変換を施した。

さらに、離散ウェーブレット逆変換を施し多重解像度解 析を行った結果は、図8と9に示した通りである。図7と 同様に最大値を 1.0 に最小値を 0.0 に正規化して濃淡で示 したものである。せん断応力の低いところは濃色(濃い灰 色) で、そして、高くなるに従い一旦淡色となり、最も高 い部分は黒色で示されている。この図において、Level0か ら Level5 とレベルが高くなるにしたがって、入力データは 低周波数成分から高周波数成分に分解され示されている。 Level6 については省略している。表示した範囲は元のデー



x-direction [X 300 µ m], y-direction [X 0.1ms]





Fig. 8. Multiresolution analysis in Re=8700.



タである図7に示すものと同範囲である。離散ウェーブレ ットは正規直交するので、各レベルをすべて加えたものは、 図7の元のせん断応力分布を示す。

〈4.2〉高せん断応力の探知 次に筆者の一人が行っている壁面せん断応力の制御を念頭に置いた高せん断応力領域の予測手続き ⁿの成績を改善するために離散ウェーブレット変換による壁面せん断応力データのフィルタリングを試みた。壁面の編状低速領域から生ずる一連のバースティングイベントによる立て渦がもたらす高せん断応力領域は、本マイクロせん断応力計により計測することが可能である。しかし、データの中には1回のバースティングイベントが通過する数 ms のオーダの変動と、これに



図10 多重解像度フィルタリング (*Re*=8700) Fig. 10. Multiresolution filtering in *Re*=8700.



図 11 多重解像度フィルタリング (*Re*=17400) Fig. 11. Multiresolution filtering in *Re*=17400.

伴う流体現象として存在する数kHz 以上の変動あるいはセンサ系の高周波ノイズ成分が混在しており、高せん断応力 領域の判別に支障を来す原因となる。これらの高周波数の 変動を除去し、高せん断応力領域の判別を明瞭化するため に離散ウェーブレット変換を用いた。

図 10 及び図 11 に先に示した Re=8700 と Re=17400 の多重 解像度解析結果を再び重ね合わせた場合のせん断応力等強 度分布を示す。ここで Level02 は Level0+Level1+Level2 を示し、Level03 及び Level04 も同様に重ね合わせを実行し た結果である。尚、各図の正規化あるいは色の濃淡、黒の 領域による等せん断応力等強度線は図8,9と同様である。

まず Re=8700 のレイノルズ数が比較的低い場合では、 Level04からLevel02と重ね合わせを変更することで高せん 断応力領域(黒色部分)(C)が鮮明に表現されていること が分かる。つまり全体の積分値からLevel5とLevel6を除 去することで顕著なフィルタリング効果が実現される。ま た Re=17400 の場合では、Level5とLevel6を除去した Level04より図7(b)からは判別が困難であった高せん断応 力領域(黒色部分)(D)等がより明確に表現されることが 分かる。さらに、Level03、Level02と高次のフィルタリン グを掛けることで、領域が縮小しかつ複雑な形状となり判 別が困難である高せん断応力領域の形状を単純化(E)する ことができ、高せん断応力領域が表現される。これは壁面 せん断応力の高周波成分が離散ウェーブレット変換のフィ ルタリング効果により除去された結果と考えられる。









また、1つのセンサが測定したサンプルデータの時間経 過を図 12 に示す。同図には元データ:data と 0103 (Leve103),0to4 (Leve104),0to5 (Leve105)が示され ている。0to5 以上ではほとんど元データと同じトレースと なる。0to4 と 0to3 が示すように、高次のレベルを排除する ことにより、忠実な変動に対する追従性は犠牲となるが、 細かな変動に妨害されずに高せん断応力の発生する位置お よび時間的な領域を把握することが可能となる。しかし、 ここでは表示していないが、0to1 や 0to2 のようにフィルタ を効かせ過ぎると時間的なずれが顕著となるので注意が必 要である。

ここで、図 13 に示すように、時空間データ全体における せん断応力の平均値 τ と実行値 τ 'より式(25)によって求め られる閾値を用いて高せん断応力領域を定義し、その領域 におけるせん断応力の最大値 Peak とせん断応力初期増加率 slope を同図に示すように定めた⁷。

 $\tau^* = (\tau - \tau) / \tau > 0.3$ · · · · · · · (25) それぞれのレイノルズ数に対して統計的な値が充分集束す るように高せん断応力領域を 250 以上抽出し、各レイノル ズ数での最大値 Peak と初期増加率 Slope との相関係数を



図 14 離散ウェーブレット変換のフィルタリング 効果による最高値と初期増加率との相関係数 Fig. 14. Correlation coefficient of Peak and Slope due to the filtering effect by discrete wavelets transform.

求めた結果を図14に示す。同図で元データ: data では相関 係数が0.45 から0.1 であるのに対し、0to3 と0to4 では各 レイノルズ数において相関係数が0.5 を越えており、相関 係数が各レイノルズ数において増加している。これは、壁 面せん断応力の高周波成分が離散ウェーブレット変換によ るフィルタリング効果によって除去されたものと考えられ、 壁面せん断応力推定に良好な結果が得られているものと期 待できる。以上のプロセスは壁面せん断応力の制御を念頭 に置いた高せん断応力領域の予測手続きに不可欠なもので あり、高せん断応力領域の認識に大きな成果を上げるもの と期待される。

5. むすび

マイクロせん断応力計により測定された壁面せん断応力 分布に対して、離散ウェーブレット変換を試みた結果次の 事が明らかとなった。

(1) 周波数帯域別にせん断応力編状構造を分離すること ができ、各周波数レベルおきに壁面せん断応力の構造を可 視化することができた。

(2)多重解像度解析をフィルタリングとして応用することにより壁面せん断応力の高せん断応力領域における最大値と初期増加率との相関係数を高く見積もることができ、 壁面せん断応力の制御を念頭に置いた高せん断応力領域の 探知改善に対する可能性を示した。

豁 辞

本研究は平成11年度日本大学理工学部特別推進研究費の 支援を受け進められたことを記し、謝意を表す。 (平成11年12月06日受付、平成12年03月13日再受付)

文 献

B.J. Cantwell: "Organized Motion in Turbulent Flow," Ann. Rev. Fluid Mech., 13, 457~515 (1981)

- (2) M.R. Head and P. Bandyopadhyay: "New Aspects of Turbulent Boundary-Layer Structure," J. Fluid Mech., 107, 297~338 (1981)
- S.J. Kline, W.C. Reynolds, F.A. Schraub and P.W. (3)Runstadler,: "The Structure of Turbulent Boundary Layers," J. Fluid Mech., 30,4, 741~773 (1967)
- (4) C.R. Smith and S.P. Metzler: "The Characteristics of Low- Speed streaks in the Near-Wall Region of a Turbulent Boundary Layer," J. Fluid Mech., 129, 27~54 (1983)
- (5) J. Kim, P. Moin and R. Moser: "Turbulent Statistics in Fully developed Channel Flow at Low Reynolds Number," J. Fluid Mech., 177, 133~166 (1987)
- (6)C.M. Ho, S. Tung, G.B. Lee, Y.C. Tai, F. Jiang T. Tsao: "MEMS- A Technology for Advancements in Aerospace Engineering," AIAA Paper 97-0545 (1997)
- (7) M. Kimura, S. Tung, J. Lew, C.M. Ho and F. JIANG and Y.C. Tai: "Measurements of Wall Shear Stress of a Turbulent Boundary Layer using a Micro-Shear-Stress Imaging Chip,", Fluid Dynamics Res., 24, 6, 329~342 (1999)
- (8) R.K.Young: "Wavelet Theory and its Applications," Kluwer Academic Publishers, USA (1993), 日本語訳, 袋谷賢吉 「ウェーブレット信号処理とシステム推 定への応用」,トッパン (1997)
- 斎藤兆古:「離散値系ウェーブレット変換の電磁界計 (9) 算への応用」電学論 A, 116A, 10, 833~839 (1996)
- (10) 緑川洋一・早野誠治・斉藤兆古:「離散値系ウェー ブレット変換によるノイズフィルタ評価の検討」, 電学論 A, 117A, 2, 128~133 (1997)
- (11) H. Li, M. Takei, M. Ochi, Y. Saito and K. Horii: "Application of Two-dimensional Orthogonal Wavelets to Multiresolution Image Analysis of a Turbulent Jet,", Trans. JSASS, 42, 137, 120~127 (1999)
- (12) 木村元昭、武居昌宏、李輝、C.M. Ho、S. Tung、越 智光昭、斎藤兆古、堀井清之:「マイクロせん断応 力計による壁面せん断応力分布の離散ウェーブレッ ト解析」、可視化情報シンポジウム講演論文集、19,1, 33~36 (1999)
- (13) F. Jiang, Y.C. Tai, B. Gupta, R. Goodman, S. Tung,, J.B. Huang and C.M. Ho: "A Surface-Micromachined Shear Stress Imager," 9th IEEE on MEMS, 110 (1996)
- (14) J.B. Huang, S. Tung, C.M. Ho, C. Liu and Y.C. Tai: "Improved Micro Thermal Shear-Stress Sensor," IEEE transactions on Instrumentation and Measurement, 45, 2, 570 (1996)
- (15) C Liu, Y.C. Tai, J.B. Hung and C.M. Ho: "Surface Micromachined Thermal Shear Stress Sensor," Application of Microfabrication to Fluid Mechanics, ASME, FED-197, 9~15 (1997)
- (16) C. Liu and Y.C. Tai: "Studies on the Sealing of Micromachined Cavities using Chemical Vapor Deposition Materials," Technical Digest, Solid-State Sensor and Actuator Workshop, 103~106 (1994)
- (17) K.C. Saraswat and H. Singh: "Theermal Oxidation of Heavily Phosphorous-Doped Thin Film of Polycrystalline Silocon," J. Electrochem. Soc., 129, 2321~2326 (1982)
- (18) H.H. Bruun: "Hot-Wire Anemometry," Oxford University Press, 272~286 (1995)
- (19) A.K.M.F. Hussain and W.C. Reynolds: "The Mechanics of a Perturbation Wave in Turbulent Shear Flow," Air Force Office of Scientific Report, 70-1655TR, 29~33 (1970)



(非会員) 1988 年日本大学大学院理工学研 究科博士課程修了。同年日本大学理工学部 助手。2000年4月同大助教授 工学博士。 1996-1997 米国 UCLA 客員研究員。噴流拡 散機構に関する研究、及び 1997 より MEMS による熱流体の計測と制御に関する研究に 従事。日本機械学会、日本航空宇宙学会、 日本流体力学会、可視化情報学会、日本太

陽エネルギー学会会員。



(非会員) 1995 年早稲田大学大学院理工学 研究科博士課程修了。同年 4 月より現職。 流体工学、特に旋回流を用いた粉粒体輸送、 ウェーブレット変換を用いた固気二相流の 解析などの研究を行っている。日本大学理 工学部機械工学科専任講師 博士(工学)。 日本機械学会、日本混相流学会、日本粉体 工学会、可視化情報学会会員。



宮城 徳誠 (非会員)1976年生まれ。1998年3月日本大 学理工学部機械工学科を卒業。2000年3月 同大学院機械工学専攻博士前期課程を修了。 同年 4 月同大学院機械工学専攻博士後期課 程において MEMS を用いた乱流現象のパ ターン認識と制御に関する研究を行ってい る。日本機械学会会員。

Chih-Ming Ho (非会員) 1967 年台湾大学機械工学科卒、



1974 年米国 Johns Hopkins 大学大学院修了 (Ph.D.)。1975-1991 年 米国 USC Faculty member。現在、米国 UCLA Ben Rich-LOCKHEED MARTIN 教授。MEMS 及び流 体力学の研究に従事。Member of US National Academy of Engineering 及び Academia Sinica。 APS Fellow 及び AIAA Fellow。





報学会、日本応用磁気学会、日本生体磁気学会会員。



(非会員)白百合女子大学文学部 教授 工 学博士(化学工学)。1967年早稲大学理工 学部卒、1987年から白百合女子大学教授。 流体工学、特にスパイラル流の基礎研究と、 その応用としての光ファイバーの通線、薬 品粉体表面改質、超撥水性材料のハンドリ ング、プラズマ流の制御などの研究を行っ ている。ASME、日本航空宇宙学会、日本

機械学会、日本混相流学会会員。